

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION
EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle
Bureau international



(43) Date de la publication internationale
29 juillet 2004 (29.07.2004)

PCT

(10) Numéro de publication internationale
WO 2004/064146 A1

(51) Classification internationale des brevets⁷ :
H01L 21/762, 21/304, 21/20

(21) Numéro de la demande internationale :
PCT/FR2003/003622

(22) Date de dépôt international :
8 décembre 2003 (08.12.2003)

(25) Langue de dépôt : français

(26) Langue de publication : français

(FR). MORICEAU, Hubert [FR/FR]; 26, rue du Four-
net, F-38120 Saint-Egreve (FR). LAGAHE, Christelle
[FR/FR]; La Guillenchière, Route de la Cascade, 38134
Saint Joseph de Rivière (FR).

(74) Mandataire : SANTARELLI; 14, avenue de la Grande
Armée, BP 237, F-75822 Paris Cedex 17 (FR).

(81) États désignés (national) : JP, US.

(84) États désignés (régional) : brevet européen (AT, BE, BG,
CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE,
IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

(30) Données relatives à la priorité :
02/15550 9 décembre 2002 (09.12.2002) FR

(71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US) : COM-
MISSARIAT A L'ÉNERGIE ATOMIQUE [FR/FR];
31/33, rue de la Fédération, F-75752 Paris Cedex 15 (FR).

(72) Inventeurs; et

(75) Inventeurs/Déposants (pour US seulement) : FOUR-
NEL, Franck [FR/FR]; 9, route des Iles, F-38530 Moirans

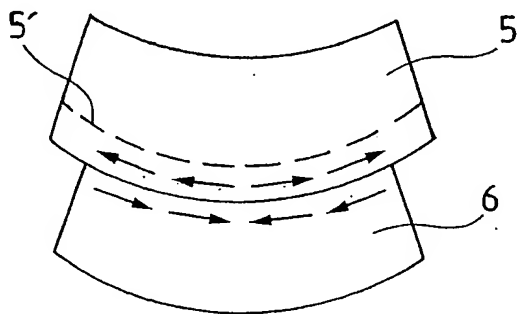
Publiée :

- avec rapport de recherche internationale
- avant l'expiration du délai prévu pour la modification des
revendications, sera republiée si des modifications sont re-
çues

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abrégia-
tions, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et
abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de
la Gazette du PCT.

(54) Title: METHOD FOR MAKING A STRESSED STRUCTURE DESIGNED TO BE DISSOCIATED

(54) Titre : PROCEDE DE REALISATION D'UNE STRUCTURE CONTRAINTE DESTINEE A ETRE DISSOCIEE



(57) Abstract: The invention concerns a method for making a complex microelectronic structure by assembling two substrates (5, 6; 11, 13) through two respective linking surfaces, said structure being designed to be dissociated at a separation zone. The invention is characterized in that it consists, prior to assembling, in producing a difference of state of tangential stresses between the two surfaces to be assembled, said difference being selected so as to obtain in the assembled structure a predetermined state of stresses at the time of dissociation.

(57) Abrégé : Procédé de réalisation d'une structure microélectronique complexe par assemblage de deux substrats (5, 6 ; 11, 13) par deux faces respectives de liaison, cette structure étant destinée à être dissociée au niveau d'une zone de séparation, caractérisé en ce que, avant assemblage, on crée une différence d'état de contraintes tangentielles entre les deux faces à assembler, cette différence étant choisie en sorte d'obtenir au sein de la structure assemblée un état de contraintes prédéterminé au moment de la dissociation.

WO 2004/064146 A1